

Porta Wafer Circolare In Ptfе Da 6 Pollici Resistente Ad Acidi E Alcalini Cestello Per Pulizia Semiconduttori Personalizzabile

Numero articolo: PL-CP207



introduzione

Porta wafer circolari in PTFE da 6 pollici ad alta purezza progettati per la pulizia dei semiconduttori. Eccellente resistenza agli acidi e agli alcali per l'incisione piranha e HF. Cestelli lavorati con precisione, completamente personalizzabili, per garantire una manipolazione sicura dei substrati durante processi chimici a umido impegnativi, bagni a immersione e risciacqui ultrasonici.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Processo di Pulizia RCA	Utilizzato per rimuovere residui organici, strati di ossido sottili e contaminazione ionica dai wafer di silicio utilizzando soluzioni SC-1 e SC-2.	L'alta resistenza termica e chimica previene la degradazione del portante durante l'immersione in bagni riscaldati.
Incisione Piranha	Manipolazione dei wafer in una miscela di acido solforico e perossido di idrogeno per rimuovere materia organica pesante.	La resistenza eccezionale agli ambienti ossidativi aggressivi garantisce una lunga durata dell'attrezzatura.
Immersioni in Acido Fluoridrico (HF)	Rimozione di strati di ossido sacrificali o ossidi nativi dalle superfici di silicio in concentrazioni variabili di HF.	La purezza del materiale previene l'introduzione di ioni metallici nell'ambiente di incisione sensibile.
Risciacquo Post-CMP	Trasporto dei wafer attraverso cicli di pulizia a seguito della Lucidatura Chimico-Meccanica per rimuovere le particelle della slurry.	Le superfici lisce e antiaderenti prevengono l'intrappolamento di particelle e facilitano una pulizia ultrasonica efficace.
Fabbricazione di Celle Solari	Lavorazione di wafer di silicio monocristallino o policristallino da 6 pollici durante le fasi di texturizzazione e diffusione del fosforo.	La costruzione robusta supporta un'elevata produttività in linee di produzione industriali impegnative.
Fotolitografia	Supporto dei substrati durante lo sviluppo e la rimozione della fotoresistenza utilizzando solventi e stripper specializzati.	La compatibilità universale con i solventi previene il rigonfiamento o l'ammorbidimento del telaio del portante.
Pulizia Ultrasonica	Trasporto di componenti delicati in bagni ultrasonici o megasonici per la rimozione di contaminanti ad alta precisione.	La rigidità strutturale permette una trasmissione efficiente dell'energia acustica alle superfici dei wafer.
Incisione Semiconduttori Composti	Lavorazione di wafer GaAs, InP o SiC in miscele chimiche specializzate per la fabbricazione di dispositivi optoelettronici.	La geometria delle fessure personalizzabile accoglie spessori di wafer variabili e materiali substrato fragili.

Parametro	Dettaglio Specifica per PL-CP207
Identificativo Modello	PL-CP207
Costruzione Materiale	PTTFE Vergine ad Alta Purezza (Opzioni PFA personalizzate disponibili)
Compatibilità Dimensione Wafer	6 Pollici / 150mm Diametro
Configurazione Geometria	Cestello di Pulizia Circolare / Tipo Cestello Fiore
Compatibilità Chimica	Resistenza universale (Acidi, Basi, Solventi, Ossidanti)
Tolleranza Temperatura	Adatto per lavorazione da criogenica ad alta temperatura
Capacità di Personalizzazione	Dimensioni, conteggio fessure e configurazioni maniglia completamente personalizzabili

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Parametro	Dettaglio Specifica per PL-CP207	
Finitura Superficiale	Lavorato con precisione, ultra-liscio, non poroso	
Capacità Lotto	Progettato su misura in base ai requisiti specifici del conteggio wafer del cliente	
Metodo di Produzione	Lavorazione CNC Su Misura / Fabbricazione Personalizzata	